

September 25, 2025
ROHM Co., Ltd.
Infineon Technologies AG

Für mehr Kundenflexibilität: ROHM und Infineon kooperieren bei Gehäusen für Siliziumkarbid-Leistungshalbleiter

Kyoto, Japan und München, Deutschland - ROHM Co., Ltd. und die Infineon Technologies AG haben eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding) zur Zusammenarbeit bei Siliziumkarbid-(SiC)-Leistungshalbleiter-Gehäusen unterzeichnet, die in Anwendungen wie Onboard-Ladegeräten, Photovoltaik, Energiespeichersystemen und KI-Rechenzentren zum Einsatz kommen. Konkret beabsichtigen die Partner, wechselseitig als zweite Bezugsquelle („Second Source“) für Kunden zu fungieren, die ausgewählte Gehäuse für SiC-Leistungshalbleiter nutzen. Damit steigt die Flexibilität der Kunden bei Design und Beschaffung. Künftig können sie Bauteile mit kompatiblen Gehäusen sowohl von ROHM als auch von Infineon beziehen. Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen stellt eine nahtlose Kompatibilität je nach spezifischem Kundenbedarf sicher.

„Wir freuen uns, gemeinsam mit ROHM die Etablierung von SiC-Leistungsschaltern im Markt weiter zu beschleunigen“, sagt Dr. Peter Wawer, Division President Green Industrial Power bei Infineon. „Unsere Zusammenarbeit bietet Kunden mehr Auswahl und Flexibilität bei Design und Beschaffung und ermöglicht die Entwicklung energieeffizienterer Anwendungen, die die Dekarbonisierung weiter vorantreiben.“

„ROHM setzt sich dafür ein, seinen Kunden bestmögliche Lösungen zu bieten. Unsere Zusammenarbeit mit Infineon ist ein wichtiger Schritt auf diesem Weg, da sie die Auswahloptionen erweitert“, sagt Dr. Kazuhide Ino, Mitglied des Vorstands, Managing Executive Officer, verantwortlich für das Power Devices Geschäft bei ROHM. „Gemeinsam können wir Innovationen vorantreiben, Komplexität reduzieren, die Kundenzufriedenheit steigern und so die Zukunft der Leistungselektronik mitgestalten.“



Dr. Peter Wawer, Division President Green Industrial Power bei Infineon (links)
und Dr. Kazuhide Ino, Vorstandsmitglied und Executive Officer bei ROHM

Im Rahmen der Vereinbarung übernimmt ROHM die innovative Top-Side-Cooling-Plattform für SiC von Infineon, einschließlich der TOLT, D-DPAK, Q-DPAK, Q-DPAK dual und H-DPAK-Gehäuse. Die Top-Side-Cooling-Plattform von Infineon bietet zahlreiche Vorteile, darunter eine Standardhöhe von 2,3 mm für alle Gehäuse. Das vereinfacht das Design und senkt die Kühlkosten, ermöglicht eine effizientere Platzausnutzung auf der Leiterplatte und eine bis zu doppelt so hohe Leistungsdichte.

Gleichzeitig wird Infineon basierend auf dem DOT-247-Gehäuse von ROHM mit SiC-Halbbrückenkonfiguration ein kompatibles Produkt entwickeln. Damit erweitert Infineon sein kürzlich angekündigtes Double-TO-247-IGBT-Portfolio um SiC-Halbbrückenlösungen. Das fortschrittliche DOT-247-Gehäuse von ROHM bietet eine höhere Leistungsdichte und reduziert den Montageaufwand im Vergleich zu Standard-Einzelgehäusen. Durch die einzigartige Struktur, die zwei TO-247-Gehäuse integriert, lassen sich der Wärmewiderstand um etwa 15 Prozent und die Induktivität um 50 Prozent im Vergleich zum TO-247 reduzieren. Diese Vorteile ermöglichen eine 2,3-fache Leistungsdichte.

ROHM und Infineon planen, ihre Zusammenarbeit künftig auf weitere Gehäuse für Silizium- und Wide-Bandgap-Leistungshalbleitertechnologien wie SiC und Galliumnitrid (GaN) auszuweiten. Damit wollen die beiden Unternehmen ihre Kooperation weiter stärken und Kunden eine noch breitere Auswahl an Lösungen und Bezugsquellen bieten.

SiC-basierte Halbleiter verbessern Hochleistungsanwendungen, indem sie Strom noch effizienter schalten, eine hohe Zuverlässigkeit und Robustheit unter extremen Bedingungen bieten und kompaktere Designs ermöglichen. Mit den SiC-Produkten von ROHM und Infineon können Kunden energieeffiziente Lösungen entwickeln und die Leistungsdichte in Anwendungen wie Ladegeräten für Elektrofahrzeuge, erneuerbaren Energiesystemen und KI-Rechenzentren erhöhen.

Über Infineon

Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.060 Beschäftigte (Ende September 2024) und erzielte im Geschäftsjahr 2024 (Ende September) einen Umsatz von rund 15 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com

Diese Presseinformation finden Sie online unter www.infineon.com/presse

Follow us: [Facebook](#) - [LinkedIn](#)

Über ROHM

ROHM, ein führender Hersteller von Halbleitern und elektronischen Komponenten, wurde 1958 gegründet. Vom Automobil- und Industrieausrüstungsmarkt bis hin zum Konsum- und Kommunikationssektor liefert ROHM über ein weltweites Vertriebs- und Entwicklungsnetz ICs, diskrete Bauelemente und elektronische Komponenten von höchster Qualität und Zuverlässigkeit. Die Stärken von ROHM im Analog- und Leistungsmarkt ermöglichen es uns, optimierte Lösungen für ganze Systeme anzubieten, die Peripheriekomponenten (z. B. Transistoren, Dioden, Widerstände) mit den neuesten SiC-Leistungsbaulementen sowie Treiber-ICs kombinieren, um deren Leistung zu maximieren.

Weitere Informationen zu ROHM erhalten Sie unter <https://www.rohm.com>
Dies Presseinformation finden Sie online unter <https://www.rohm.com/news-detail>
Follow us: [Facebook](#) - [LinkedIn](#)